

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1167—2016

硅单晶腐蚀片

Monocrystalline silicon etched wafers

2016-07-11 发布

2017-01-01 实施

中华人民共和国有色金属
行业标准
硅单晶腐蚀片
YS/T 1167—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2018年9月第一版

*

书号: 155066·2-44939

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准起草单位:天津市环欧半导体材料技术有限公司、天津中环领先材料技术有限公司、洛阳鸿泰半导体有限公司、有研半导体材料有限公司、杭州海纳半导体有限公司。

本标准主要起草人:由佰玲、张雪囡、蒋建国、孙燕、王飞尧、沈浩平。

硅单晶腐蚀片

1 范围

本标准规定了硅单晶腐蚀片的牌号及分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单(或合同)内容。

本标准适用于直拉法、悬浮区熔法(包括区熔中子嬗变和气相掺杂)制备的硅单晶研磨片经化学腐蚀液去除表面损伤层后制备的酸腐蚀片和碱腐蚀片(以下简称腐蚀片)。产品主要用于制作晶体管、整流管、特大功率晶闸管、光电器件等半导体元器件或进一步加工成硅抛光片。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法
- GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 6616 半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻率测试方法 非接触涡流法
- GB/T 6618 硅片厚度和总厚度变化测试方法
- GB/T 6620 硅片翘曲度非接触式测试方法
- GB/T 11073 硅片径向电阻率变化的测量方法
- GB/T 12962 硅单晶
- GB/T 12965 硅单晶切割片和研磨片
- GB/T 13387 硅及其他电子材料晶片参考面长度测量方法
- GB/T 13388 硅片参考面结晶学取向 X 射线测试方法
- GB/T 14140 硅片直径测量方法
- GB/T 14264 半导体材料术语
- GB/T 14844 半导体材料牌号表示方法
- GB/T 20503 铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜镜面反射率和镜面光泽度的测定 20°、45°、60°、85°角度方向
- GB/T 26067 硅片切口尺寸测试方法
- GB/T 29505 硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法
- GB/T 30453 硅材料原生缺陷图谱
- YS/T 26 硅片边缘轮廓检验方法
- YS/T 28 硅片包装

3 术语和定义

GB/T 14264 和 GB/T 30453 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。